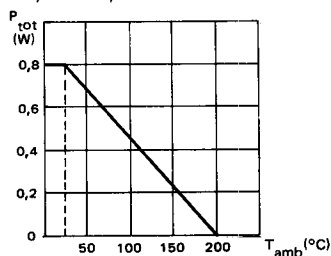


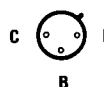
- HF amplification
Amplification HF
- Switching
Commutation

V_{CBO}	120 V
$h_{21E}(150 \text{ mA})$	40 - 120
V_{CEsat}	0,35 V max 2N 2243
(150 mA/15 mA)	0,25 V max 2N 2243 A

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale



Case TO-39 – See outline drawing CB-7 on last pages
Boîtier Voir dessin coté CB-7 dernières pages



Weight : 0,9 g.
Masse

Collector is connected to case
Le collecteur est relié au boîtier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
 VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

$T_{amb} = +25 °C$

(Unless otherwise stated)
 (Sauf indications contraires)

Collector-base voltage <i>Tension collecteur-base</i>		V_{CBO}	120	V
Collector-emitter voltage <i>Tension collecteur-émetteur</i>		V_{CEO}	80	V
Emitter-base voltage <i>Tension émetteur-base</i>		V_{EBO}	7	V
Collector current <i>Courant collecteur</i>		I_C	1	A
Power dissipation <i>Dissipation de puissance</i>	$T_{amb} = 25°C$	P_{tot}	0,8	W
	$T_{case} = 25°C$		2,8	W
Junction temperature <i>Température de jonction</i>	max.	T_j	200	°C
Storage temperature <i>Température de stockage</i>	min.	T_{stg}	- 65	°C
	max.		+200	°C

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
 $T_{amb} = 25^{\circ}C$

 (Unless otherwise stated)
 (Sauf indications contraires)

	Test conditions <i>Conditions de mesure</i>		Min.	Typ.	Max.
Collector-base cut-off current <i>Courant résiduel collecteur-base</i>	$V_{CB} = 60 V$ $I_E = 0$	I_{CBO}		10	nA
	$V_{CB} = 60 V$ $I_E = 0$ $T_{amb} = 150^{\circ}C$			15	μA
Emitter-base cut-off current <i>Courant résiduel émetteur-base</i>	$V_{EB} = 5 V$ $I_C = 0$	I_{EBO}		50	nA
Collector-base breakdown voltage <i>Tension de claquage collecteur-base</i>	$I_C = 100 \mu A$ $I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}^*$	120		V
Collector-emitter breakdown voltage <i>Tension de claquage collecteur-émetteur</i>	$I_C = 25 mA$ $I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}^*$	80		V
Emitter-base breakdown voltage <i>Tension de claquage émetteur-base</i>	$I_E = 100 \mu A$ $I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	7		V
Static forward current transfer ratio <i>Valeur statique du rapport de transfert direct du courant</i>	$V_{CE} = 10 V$ $I_C = 0,1 mA$	h_{21E}		15	
	$V_{CE} = 10 V$ $I_C = 10 mA$			30	
	$V_{CE} = 10 V$ $I_C = 10 mA$ $T_{amb} = -55^{\circ}C$			20	
	$V_{CE} = 10 V$ $I_C = 150 mA$	h_{21E}^*	40	120	

 * Pulsed
 Impulsions $t_p = 300 \mu s$ $\delta \leq 2\%$

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
 $T_{amb} = 25^{\circ}C$ (Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

	Test conditions <i>Conditions de mesure</i>			Min.	Typ.	Max.	
Static forward current transfer ratio <i>Valeur statique du rapport de transfert direct du courant</i>	$V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 500\text{ mA}$	h_{21E}^*		15			
	$V_{CE} = 1\text{ V}$ $I_C = 150\text{ mA}$			30			
Collector-emitter saturation voltage <i>Tension de saturation collecteur-émetteur</i>	$I_C = 150\text{ mA}$ $I_B = 15\text{ mA}$	V_{CEsat}	2N 2243 2N 2243A	0,35 0,25			V V
Base-emitter saturation voltage <i>Tension de saturation base-émetteur</i>	$I_C = 150\text{ mA}$ $I_B = 15\text{ mA}$	V_{BEsat}			1,3		V

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Forward current transfer ratio <i>Rapport de transfert direct du courant</i>	$V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 50\text{ mA}$ $f = 20\text{ MHz}$	h_{21e}		2,5			
Output capacitance <i>Capacité de sortie</i>	$V_{CB} = 10\text{ V}$ $I_E = 0$ $f = 1\text{ MHz}$	C_{22b}			15		pF

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-ambient thermal resistance <i>Résistance thermique (jonction-ambiante)</i>		$R_{th(j-a)}$		220		$^{\circ}C/W$
Junction-case thermal resistance <i>Résistance thermique (jonction-boîtier)</i>		$R_{th(j-c)}$		58		$^{\circ}C/W$

*Pulsed
En impulsions

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

